

关键指标

频率: DC~6GHz
 插入损耗: 0.8dB
 隔离度: 21dB
 1dB 压缩点输入功率: 37dBm@5.5GHz
 控制电平: 0/+5V 或 0/-5V
 芯片尺寸: 1.1mm×0.65mm

产品简介

HG124K2 是一款高功率匹配式单刀双掷开关芯片, 插入损耗为 0.8dB, 隔离度大于 20dB, 采用正电或者负电控制, 0/-5V 条件下 P-1@5.5GHz 为 37dBm, 输入输出端无隔直电容。

电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~6		
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
插入损耗(dB)	-	0.8	-
隔离度(dB)	-	21	-

真值表 (两种控制方式任选其一)

正电压控制

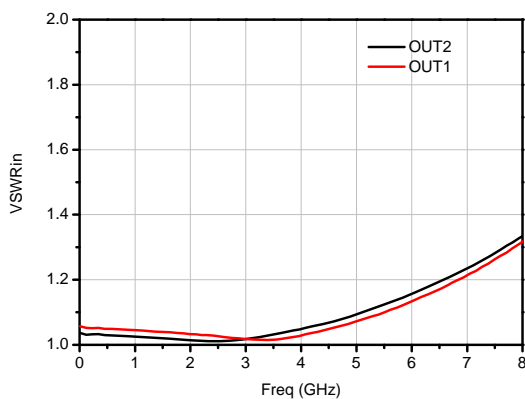
V1	V2	IN-OUT1	IN-OUT2
+5V	0V	ON	OFF
0V	+5V	OFF	ON

负电压控制

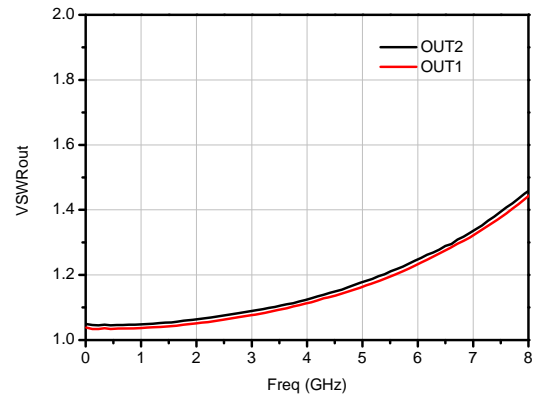
V1	V2	IN-OUT1	IN-OUT2
0V	-5V	ON	OFF
-5V	0V	OFF	ON

典型测试曲线

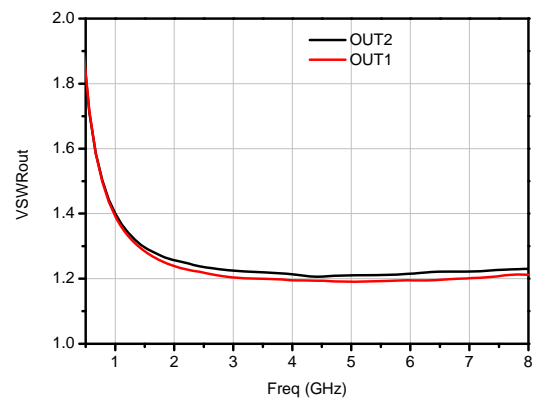
输入驻波



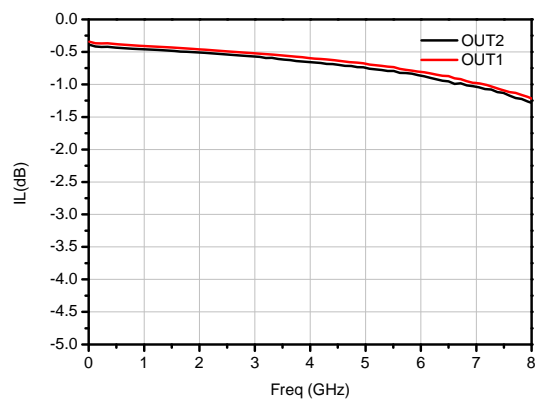
输出驻波(导通态)



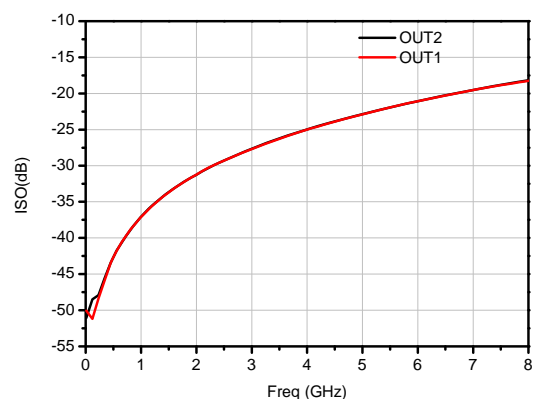
输出驻波(关断态)

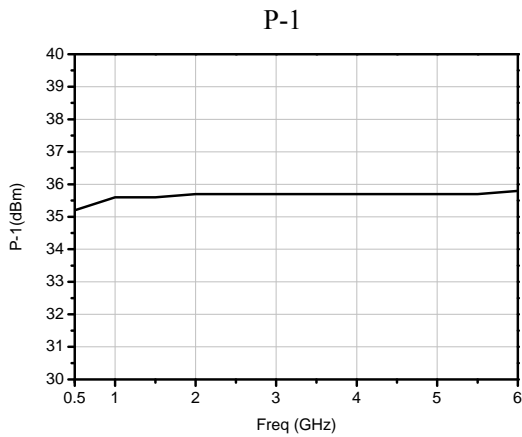


插入损耗

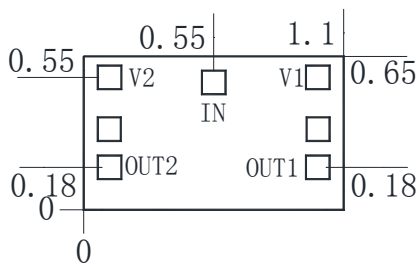


隔离度

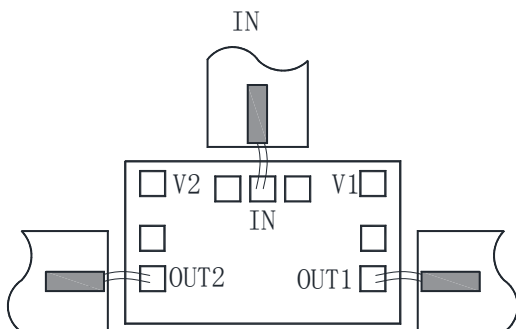




外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+38dBm	
正电控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 2.8~5V
负电控制电压	低电平: -2.8~-5V	高电平: 0~0.5V
工作温度	-55℃~125℃	
存储温度	-65℃~150℃	

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。